

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

MESC TECHNICAL NEWS

No. M16C-29-9906

M16C/62、M16C/6N フラッシュメモリ版 ブートモードに関する注意事項(2)

1. 対象品種

フラッシュメモリ 5V 版 : M30624FGFP、M30624FGGP、M30625FGGP
M306N0FGTFP

フラッシュメモリ 3V 版 : M30624FGLFP、M30624FGLGP、M30625FGLGP

2. 注意事項

ブートモードを使用して、オンボード書き換えを行うときに、リセット信号によって内蔵RAMの内容が変わる可能性があります(これはリセット解除時、外部アドレスバスに接続するポートの電位により内部アドレスが内蔵RAMを示すことによって発生するもので、ブートモードのみで発生します)。ブートモードでは、ブートROM領域の制御プログラムを内蔵RAMに転送し、そのプログラムで内蔵フラッシュメモリの制御を行います。プログラムの転送は、電源投入時に一度だけ行われるのに対し、ライターによっては、リセット信号はコマンドごとに発生します。そのようなライターでは、内蔵RAM上のプログラムが破壊されるので、ブートプログラムが正常に実行されない可能性があります。

3. 対策

ブートモード時、アドレスバス上位4ビット(A₁₆ ~ A₁₉)のうち、いずれかの端子をプルアップしてください。アドレスバスが10000₁₆番地以降を示すようにしておけば、問題は発生しません。